



Зона		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		C27, C28	Конденсатор C1210C106M6PACTU, ф. Kemet, США	2	имп. изд.
		C29	Конденсатор CC0603KRX7R9BB104, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
		C30	Конденсатор EEHZK1V101XV, ф. Panasonic, Япония	1	имп. изд.
		C31	Не устанавливать	1	имп. изд.
		C32-C34	Конденсатор CC0603KRX7R7BB105, ф. Yageo, Тайвань	3	имп. изд.
		C35	Не устанавливать	1	имп. изд.
		C36, C37	Конденсатор CC0603KRX7R7BB105, ф. Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
			Микросхемы		
		DA1	Микросхема K7805-500R3, ф. Mornsun Power, Китай	1	имп. изд.
		DA2	Микросхема TLV70233DBVT, ф. Texas Instruments, США	1	имп. изд.
		DA3	Микросхема SN74LVC1G3157DBVR,	1	имп. изд.
			ф. Texas Instruments, США		
		DA4	Микросхема LMV321DBVT, ф. Texas Instruments, США	1	имп. изд.
		DA5	Микросхема LT3741EFE#PBF, ф. Analog Devices, США	1	имп. изд.
		DA6	Микросхема INA199A1DCKT, ф. Texas Instruments, США	1	имп. изд.
		DA7	Микросхема LMV321DBVT, ф. Texas Instruments, США	1	имп. изд.
		DD1	Микроконтроллер STM32F030C8T6,	1	имп. изд.
			ф. ST Microelectronics, Швейцария		
		DD2	Микросхема MAX232ID, ф. Texas Instruments, США	1	имп. изд.
Инв. № подл.					
Инв. № докл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					
Подл. и дата					
Инв. № подл.					
Взам. инв. №					



Зона		Поз. обозначение	Наименование			Кол.	Примечание
		R12	Не устанавливать			1	имп. изд.
		R13	Резистор RC0603FR-07100KL, ф. Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R14	Резистор RC0603FR-0782KL, ф. Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R15	Резистор RC0603FR-0751KL, ф. Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R16	Резистор RC0603FR-0747KL, ф. Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R17	Не устанавливать			1	имп. изд.
		R18	Резистор RC0603FR-070RL, ф. Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R19, R20	Резистор RC0603FR-0710RL, ф. Yageo, Тайвань			2	имп. изд.
		R21	Не устанавливать			1	имп. изд.
		R22, R23	Резистор WSLP25125L000JEA, ф. Vishay, США			2	имп. изд.
		R24, R25	Не устанавливать			2	имп. изд.
		R26	Потенциометр 3224W-1-503E, ф. Bourns, США			1	имп. изд.
		R27, R28	Резистор RC0603FR-07100KL, ф. Yageo, Тайвань			2	имп. изд.
		R29, R30	Не устанавливать			2	имп. изд.
Подп. и дата							
Инв. № дубл.			Диоды				
		VD1	Диод SMAJ36CAHE3/61, ф. Vishay Semiconductors, США			1	имп. изд.
		VD2	Диод PMEG6010CEH, ф. NXP Semiconductors, Китай			1	имп. изд.
Взам. инв. №		VD3	Стабилитрон BZX384-C12, ф. Nexperia, Нидерланды			1	имп. изд.
		VD4	Диод PMEG6010CEH, ф. NXP Semiconductors, Китай			1	имп. изд.
		VD5	Не устанавливать			1	имп. изд.
Подп. и дата		VD6	Диод PMEG6010CEH, ф. NXP Semiconductors, Китай			1	имп. изд.
Инв. № подл.							
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РЕУН.468172.001 ПЭЗ ТЭ	Лист
							4



*Лист регистрации изменений*

РЕУН.468172.001 ПЭЗ ТЭ

Augm

6